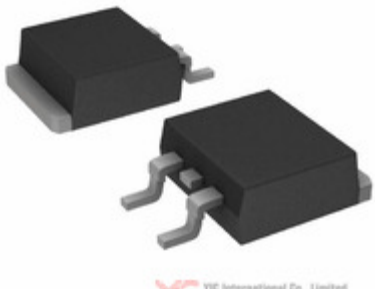









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB120N10S403ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB120N10S403ATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB120N10S403ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 180µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10120pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	140nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPB120N10S403ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB120N10S403ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB120N10S403ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB120N10S403ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB120P04P4L03ATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 40V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB120P04P4L-03 INFINEON IPB120P04P4L-03 INFINEON</p>	 <p>IPB120N08S403ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB120N08S404ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>
 <p>IPB120N10S405ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB120P04L03 INFINEON IPB120P04L03 INFINEON</p>	 <p>IPB120N06S4H1ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB120N06S403ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB120N10S403ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB120N10S403ATMA1 Datenblatt	IPB120N10S403ATMA1-Datenblätter	IPB120N10S403ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB120N10S403ATMA1
IPB120N10S403ATMA1 Electronic	IPB120N10S403ATMA1-Komponenten	IPB120N10S403ATMA1-Verteiler	IPB120N10S403ATMA1-Bild	IPB120N10S403ATMA1-Teil
IPB120N10S403ATMA1 Preis	IPB120N10S403ATMA1 Hersteller	IPB120N10S403ATMA1 Bild	IPB120N10S403ATMA1 Aktie	IPB120N10S403ATMA1 Inventar
IPB120N10S403ATMA1 Neu	IPB120N10S403ATMA1 Original	IPB120N10S403ATMA1 garantiert	IPB120N10S403ATMA1 RFQ	IPB120N10S403ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited